Draft Version

MỤC LỤC

ΜŲ	C LŲ	JC	2 -
Bài 1	tập ı	nhóm 1	4 -
1	Dio	de	4 -
2	-	Transistor BJT	4 -
3	ı	FET	4 -
	a.	Phân cực cố định	4 -
	b.	Tự phân cực	4 -
	c.	Phân cực bằng phân áp	4 -
	d.	Phân cực bằng hồi tiếp điện áp	4 -
Bài 1	tập ı	nhóm 2	4 -
3	Ú'n٤	g dụng Op Amp	4 -
4	Ú'n٤	g dụng IC số	5 -
	4.1	Biểu diễn hàm logic dưới dạng bảng trạng thái, bìa Karnaugh	5 -
	4.2	2 Tối thiều hóa hàm logic bằng bìa Karnaugh	5 -
	4.3	Biểu diễn mạch logic bằng các phần tử logic	5 -
	Μą	ạch điều khiển đèn, đồng hồ số	5 -
	Μą	ạch dùng NAND 2 đầu vào	5 -
	Μą	ạch dùng NOR 2 đầu vào	5 -
Chu	ong	g 1 Diode	6 -
1	Mạ	ch phân cực	6 -
	1.1	Mạch có hai nguồn dương	6 -
2	Mạ	ch chỉnh lưu nửa chu kỳ	7 -
Ν	1ạch	n hạn chế trên song song	8 -
	a K	íhi không có tải Rt	8 -
	b C	Có tải	9 -
Ν	1ạch	n hạn chế trên nối tiếp	- 10 -
	a K	hông có tải	- 10 -
	b C	Có tải Rt	- 10 -
3	Mạ	ch hạn chế dưới song song	- 11 -
	a K	íhông có tải	- 11 -
	b C	Có tải	- 12 -

	4 Mạch hạn chế dưới nối tiếp	- 13 -
	a Không có tải	- 13 -
	b Có tải	- 13 -
	Mạch hạn chế trên dưới dùng diode Zener	- 14 -
	Mạch hạn chế trên dưới dùng diode thường	- 16 -
CH	IƯƠNG 2 BJT	- 19 -
	1 Đặc tuyến vào	- 19 -
	2 Đặc tuyến ra	- 22 -
	2 Phân cực base	- 23 -
	4 Phân cực phân áp	- 25 -
	9 Tìm β (h _{FE})	- 26 -
CH	IƯƠNG 3 FET	- 28 -
	1 Đặc tuyến ra JFET	- 29 -
	2 Đặc tuyến ra D MOSFET	- 31 -
	3 Đặc tuyến ra của E MOSFET	- 31 -
CH	IƯƠNG 4 IC KĐTT	- 34 -
	4.1 Mạch khuếch đại đảo : tham khảo slilde bài giảng	- 34 -
	4.2 Mạch khuếch đại không đảo : tham khảo slilde bài giảng	- 34 -
	4.3 Mạch so sánh	- 34 -
	Mạch so sánh đảo	- 34 -
	Un bằng không	- 34 -
	Ung khác không	- 35 -
	Mạch so sánh không đảo	- 36 -
	Mạch Schmitt Trigger	- 37 -
	Mạch Schmitt Trigger đảo	- 37 -
	Mạch Schmitt Trigger không đảo	- 37 -
	TÀI LIẾU THAM KHẢO	- 39 -

Bài tập nhóm 1

Vẽ và mô phỏng các mạch sử dụng Transistor BJT, FET

1 Diode

- 1.1 Mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ
- 1.2 Mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ
- 1.3 Mạch chỉnh lưu cầu
- 1.4 Mạch ổn áp
- 1.5 Mạch hạn chế

2 Transistor BJT

- 2.1 Đặc tuyến vào EC
- 2.2 Đặc tuyến ra EC
- 2.3 Mạch phân cực Base
- 2.4 Mạch phân cực Emitter
- 2.5 Mạch phân cực phân áp
- 2.6 Mạch phân cực hồi tiếp Collector

3 FET

- 3.1 Đặc tuyến ra của JFET
- 3.2 Đặc tuyến truyền đạt của JFET
- 3.3 Đặc tuyến ra của D-MOFET
- 3.4 Đặc tuyến truyền đạt của D-MOSFET
- 3.5 Đặc tuyến ra của E-MOSFET
- 3.6 Đặc tuyến truyền đạt của E-MOSJFET
- 3.7 Các phương pháp phân cực
 - a. Phân cực cố định
 - b. Tự phân cực
 - c. Phân cực bằng phân áp
 - d. Phân cực bằng hồi tiếp điện áp

Bài tập nhóm 2

Vẽ và mô phỏng các mạch sử dụng Op Amp và IC số

3 Ứng dụng Op Amp

- 3.1 Mạch khuếch đại không đảo
- 3.2 Mạch khuếch đại đảo
- 3.3 Mạch cộng không đảo
- 3.4 Mạch cộng đảo
- 3.5 Mạch trừ
- 3.6 Mạch tích phân
- 3.7 Mạch vi phân

4 Ứng dụng IC số

- 4.1 Biểu diễn hàm logic dưới dạng bảng trạng thái, bìa Karnaugh
- 4.2 Tối thiều hóa hàm logic bằng bìa Karnaugh
- 4.3 Biểu diễn mạch logic bằng các phần tử logic Mạch điều khiển đèn, đồng hồ số...

Mạch dùng NAND 2 đầu vào Mạch dùng NOR 2 đầu vào

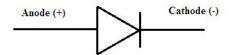
Chương 1 <u>Diode</u>Điốt

Một số quy ước

1 Nguồn một chiều E

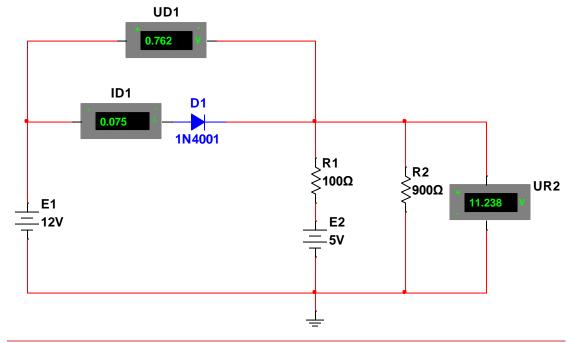
2 Điện áp UD

UD=UA-UK

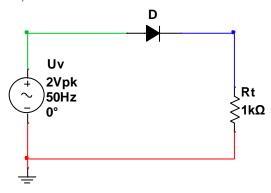


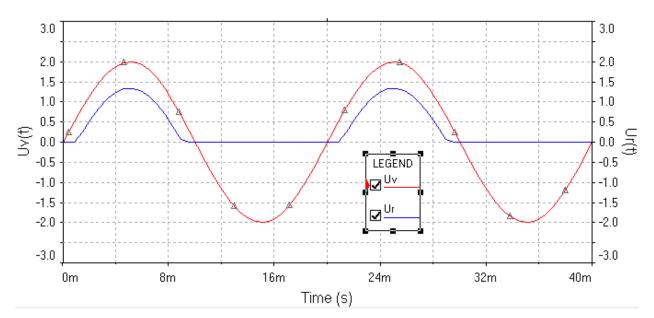
1 Mạch phân cực

1.1 Mạch có hai nguồn dương



2 Mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ





D lý tưởng

Khi $Uv > 0 \rightarrow D$ pct $\rightarrow Ur = Uv$

Khi Uv < 0 -> D pcn -> Ur = 0

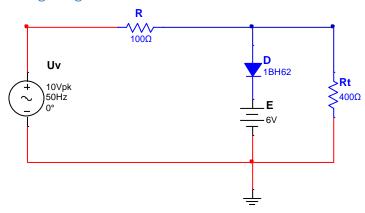
D k lý tưởng

Khi Uv \geq =UDo \rightarrow D pct \rightarrow Ur = Uv \rightarrow UDo ; Urm = Uvm \rightarrow UD \rightarrow UDo

URt = E - UDo

Khi Uv < UDo -> ID = 0 -> Ur = URt = ID.Rt = 0

Mạch hạn chế trên song song



Hình 1 Mạch hạn chế trên song song

a Khi không có tải Rt

Nguyên lý hoạt động

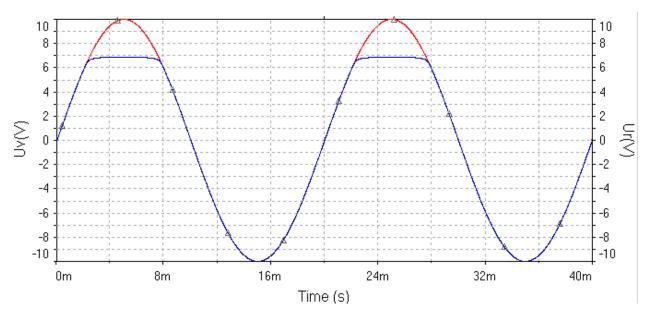
Uv> E+UD \rightarrow D phân cực thuận \rightarrow Ur = E + UD

Uv <=E+UD → D phân cực ngược →Ur=Uv-I.R= Uv

Ví dụ

 $Uv=8V>E+UD \rightarrow D$ phân cực thuận $\rightarrow Ur=E+UD$

Uv=-10V <=E+UD → D phân cực ngược →Ur=Uv-I.R



Hình 2 Khi không có tải

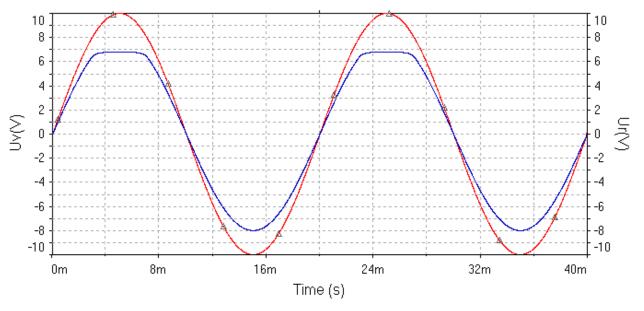
b Có tải

Nguyên lý hoạt động

 $Uv.R(R+Rt)>E+UD \rightarrow D$ phân cực thuận $\rightarrow Ur=E+UD$

 $Uv.R(R+Rt) \le E+UD \rightarrow D$ phân cực ngược $\rightarrow Ur=Uv-I.R=Uv.Rt/(R+Rt)=0.8Uv$

Mạch hạn chế ở mức E+UD



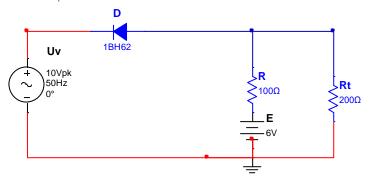
Hình 3 Khi có tải

Ví dụ

Uv = 8V; $Uv.R(R+Rt) > E+UD \rightarrow D$ phân cực thuận $\rightarrow Ur = E + UD$

Uv = -10V; $Uv.R(R+Rt) < E+UD \rightarrow D$ phân cực ngược $\rightarrow Ur = Uv-I.R= Uv.Rt/(R+Rt) = 0.8Uv$

Mạch hạn chế trên nối tiếp



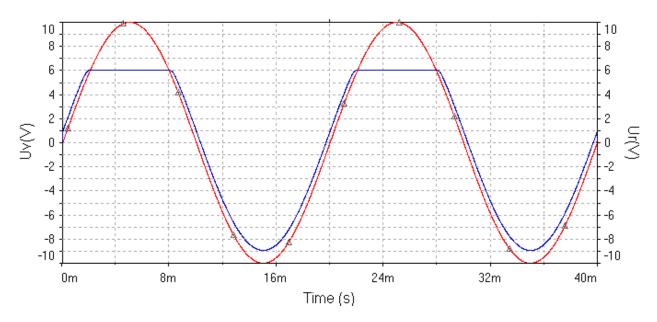
Hình 4 Mạch hạn chế trên nối tiếp

a Không có tải

Uv< E → D phân cực thuận → Ur = Uv - UD

Uv >=E → D phân cực ngược → Ur=E-I.R= E

Mạch hạn chế trên mức E



Hình 5 Không có tải

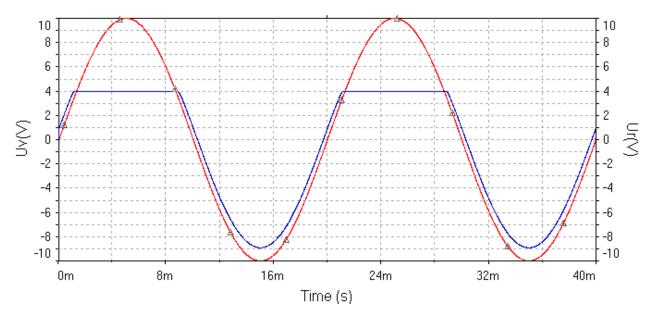
b Có tải Rt

Nguyên lý

 $Uv < E.R/(R+Rt) \rightarrow D$ phân cực thuận $\rightarrow Ur = Uv_{\underline{-}}+UD$

 $Uv >= E.R/(R+Rt) \rightarrow D$ phân cực ngược $\rightarrow Ur = E-I.R = E.Rt/(R+Rt)$

Mạch hạn chế trên mức E.Rt(R+Rt)



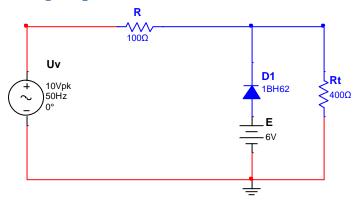
Hình 6 Có tải

Ví dụ

Khi Uv =0V → D phân cực thuận → Ur=Uv+UD

Khi Uv=10V→ D phân cực ngược → Ur=4V

3 Mạch hạn chế dưới song song

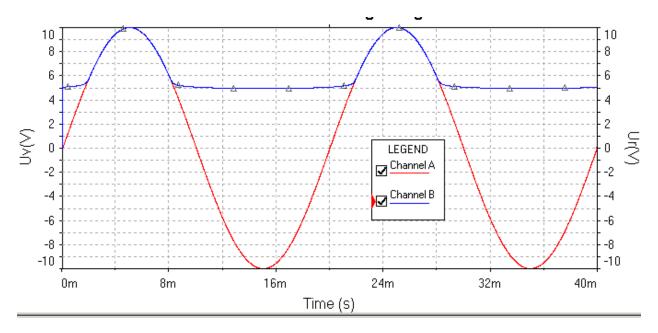


Hình 7 Mạch hạn chế dưới song song

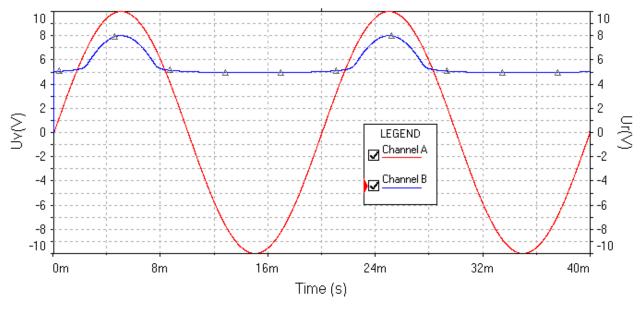
a Không có tải

Uv>E → D phân cực ngược → Ur=Uv

Uv<=E → D phân cực thuận → Ur=E-UD

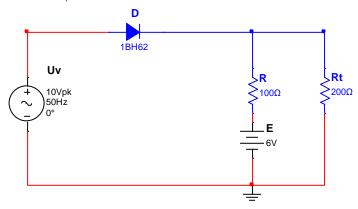


Hình 8 Không có tải



Hình 9 Có tải

4 Mạch hạn chế dưới nối tiếp

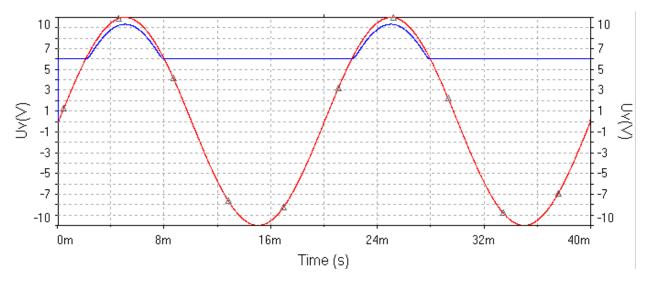


Hình 10 Mạch hạn chế dưới nối tiếp

a Không có tải

Uv >E → D phân cực thuận → Ur=Uv-UD

Uv<=E → D phân cực ngược →Ur=E



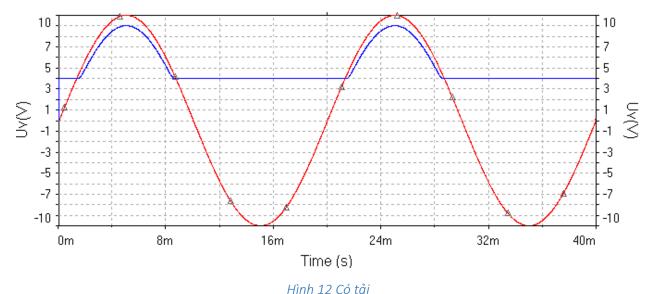
Hình 11 Không có tải

b Có tải

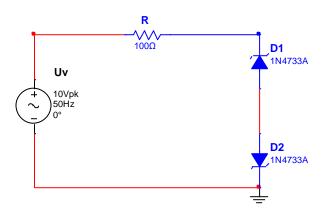
 $Uv > E.Rt/(R+Rt) \rightarrow D$ phân cực thuận $\rightarrow Ur=Uv-UD$

 $Uv \le E.Rt/(R+Rt) \rightarrow D$ phân cực ngược $\rightarrow Ur = E.Rt/(R+Rt)$

Mạch hạn chế dưới mức E.R/(R+Rt)



Mạch hạn chế trên dưới dùng diode Zener



Hình 10 Mạch hạn chế trên dưới

Nguyên lý

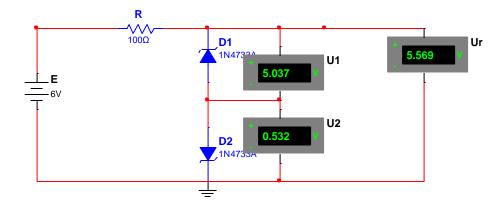
Uv >Uz1→ D1 phân cực ngược, D2 phân cực thuận → Ur =Uz1 + UD2 (Hình 11)

Uv<-Uz2→ D1 phân cực thuận, D2 phân cực ngược → Ur =-(Uz2 + UD1)

-Uz<=Uv<0 → D1 phân cực thuận, D2 phân cực ngược→ Ur =Uv

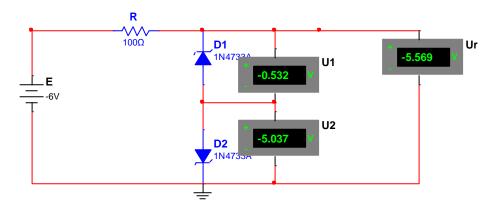
Uv<=Uz→ D1 phân cực ngược, D2 phân cực thuận→ Ur =Uv

Với Uz=UK-UA là điện áp danh định của diode Zener theo datasheet, ví dụ với 1N4733A thì Uz=5,1V



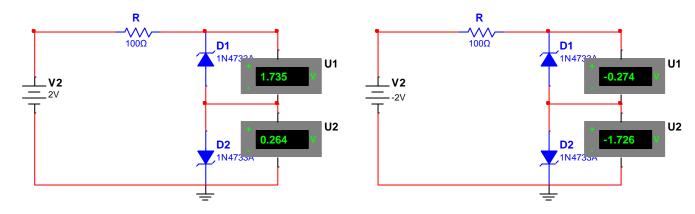
Hình 11

Ur = Uz1 + UD2

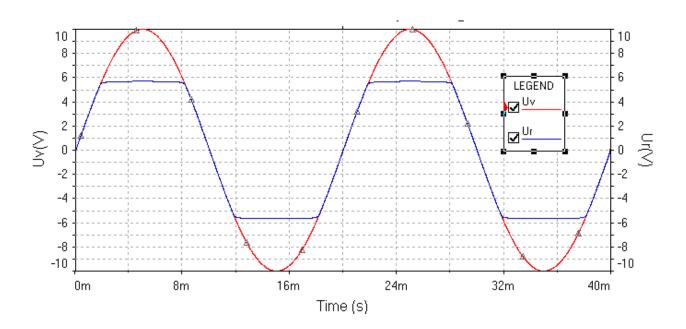


Hình 12

Ur = -(Uz2+UD1)

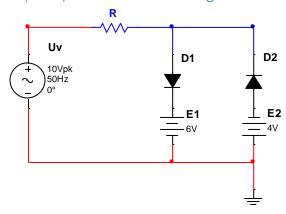


Hình 13



Hình 14 Mach han chế trên dưới

Mạch hạn chế trên dưới dùng diode thường

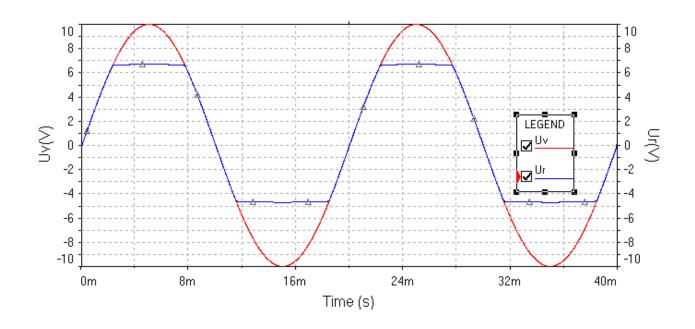


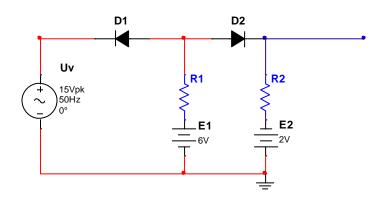
Hình Mắc song song

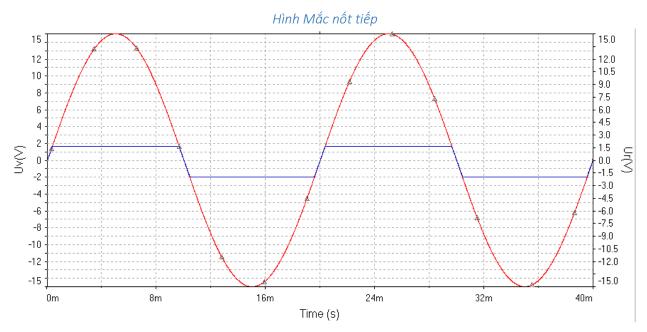
Uv >E1→ D1 phân cực thuận, D2 phân cực ngược → Ur =E1+ UD1 (Hình 1?)

 $Uv < E2 \rightarrow D1$ phân cực ngược, D2 phân cực thuận $\rightarrow Ur = E2 - UD2 = -4 - 0,7 = -(E2 + UD2)$

E2<=Uv<=E1→ D1 phân cực ngược, D2 phân cực ngược→ Ur =Uv-I.R= Uv

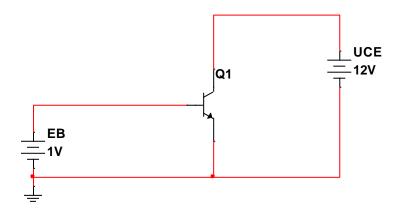




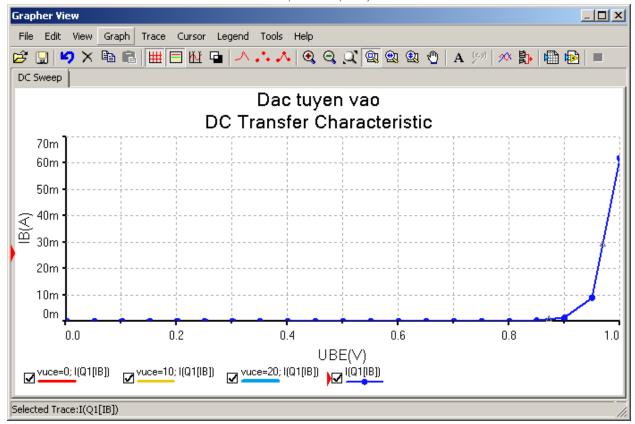


CHƯƠNG 2 BJT

1 Đặc tuyến vào



Hình 13 Mạch đo đặc tuyến vào

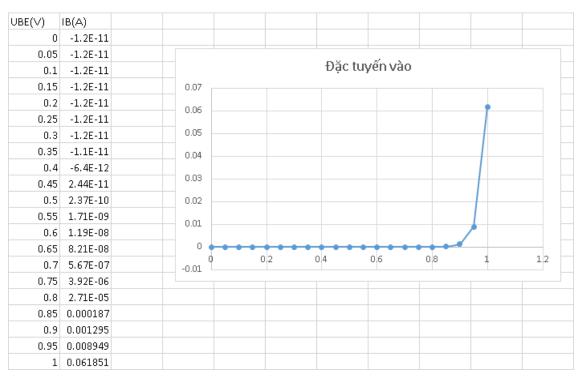


Hình 14 Đặc tuyến vào

Đặc tuyến cso dạng giống đặc tuyến V-A (vùng phân cực thuận) do JE phân cực thuận

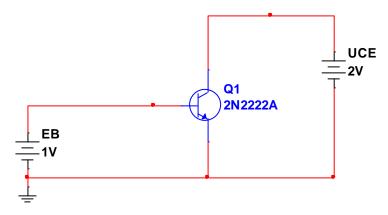
EB : [0-1] V → UBE : [0-1] V

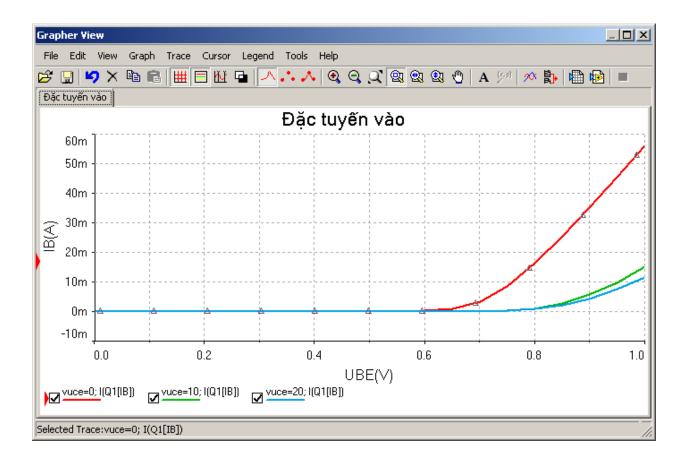
Ta có thể xuất dữ liệu đo ra file exel và vẽ đặc tuyến vào : Chọn View→ Grapher → Grapher View Tools→Export to excel



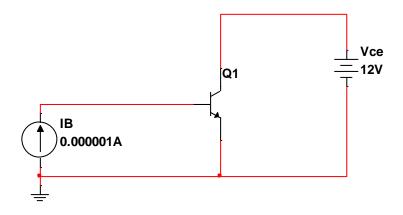
Hình 15 Đặc tuyến vào (2)

Thay TRANSISTOR 2N2222A

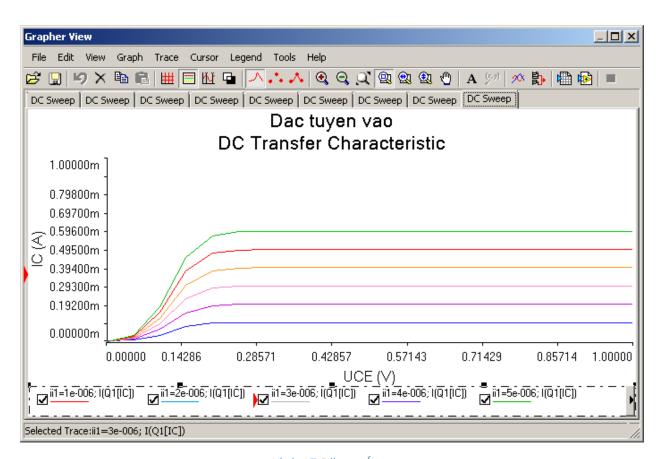




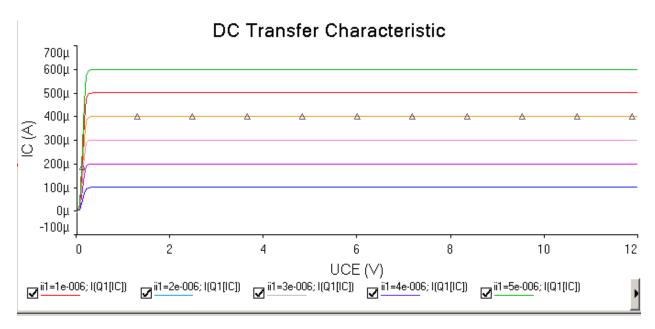
2 Đặc tuyến ra



Hình 16 Mạch đo đặc tuyến ra



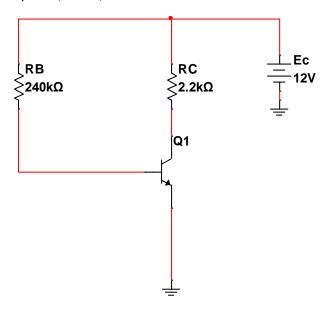
Hình 17 Đặc tuyến ra



Hình 18 Đặc tuyến ra (2)

2 Phân cực base

Tìm điểm Q? Vẽ đường tải? β =100; U_{BE} =0,7V



Hình 19 Phân cực base

Phân tích

Mạch vào:

 $E_C = U_{BE} + I_B R_B$

 \rightarrow I_B= (E_B-U_{BE})/R_B

 \rightarrow I_C= β . I_B

Mạch ra:

$$E_C = U_{CE} + I_C R_C$$

$$=> U_{CE} = E_C - I_C R_C$$

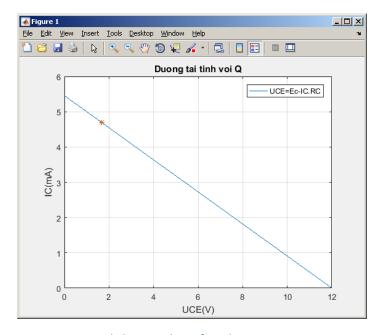
Thay số

- $I_B = (E_C U_{BE}) / R_B$ = $(12 - 0.7)/240k = 0.047 \text{ mA} = 47 \mu\text{A}$
- $I_C = \beta \times I_B = 100 \times 0.047 \mu A = 4,7 \text{ mA}$
- $U_{CE} = E_C I_C \times R_C$: pt đường tải = $12 - 4,7mA \times 2.2k = 1,66 \text{ V}$

Điểm làm việc tĩnh Q (I_B = 47 μ A; I_C = 4,7 mA; U_{CE} = 1,66V)

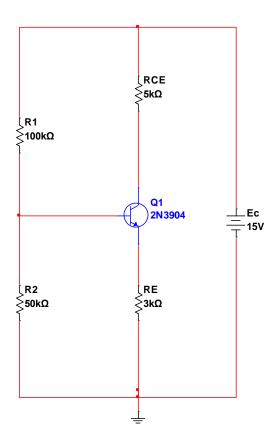
Vẽ đường tải

- Icmax = Ec/Rc=12/2,2k =~5,45mA
- UCEmax = Ec=12V



Hình 20 Đường tải tĩnh

4 Phân cực phân áp



Hình 21 Phân cực phân áp

Xác định điểm làm việc tĩnh Q

$$R_{th} = R_1 / / R_2 = \frac{R1R2}{R1 + R2}$$

$$E_{th} = E_C \frac{R2}{R1 + R2} = 5V$$

Mạch vào : Tính được $I_{BQ}I_{CQ}$

 $E_{th}=I_BR_{th}+U_{BE}+I_ER_E$

Với $I_E = (\beta + 1)I_B$

Và U_{BE}=0.7V(Si) và 0.3(Ge)

Thì
$$I_B = \frac{Eth - UBE}{Rth + (\beta + 1)RE}$$

Do $I_C = \beta I_B$

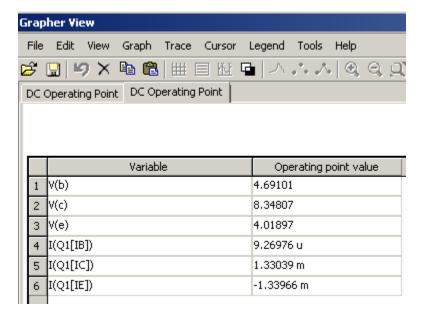
$$I_C = \beta \frac{\text{Eth-UBE}}{Rth + (\beta + 1)RE}$$

Mạch ra : Tìm U_{CEQ}

 $E_C = I_C R_C + U_{CE} + I_E R_E$

Với I_C≈I_E

$=>U_{CEQ}=E_C-I_{CQ}(R_E+R_C)$



Hình 22 Điểm làm việc tĩnh theo Multisim

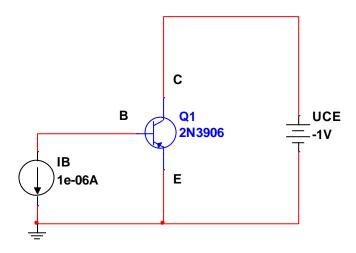
Theo kết quả mô phỏng

Ta có : β = IC/IB=1,33mA/9,269 μ A =143

UBE = Ve-Vb= 4,69-4,02=0,67V

9 Tìm β (h_{FE})

TRANSISTOR 2N3904



DC Operating Point Analysis

	Variable	Operating point value		
1	V(c)	1.00000		
2	I(Q1[IB])	999.99908 n		
3	I(Q1[IC])	94.91900 u		

$$\beta = \frac{IC}{IB} = \frac{94,9 \mu A}{999 nA} = 95$$

DC Operating Point Analysis

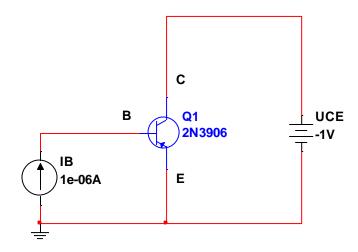
	Variable	Operating point value			
1	V(c)	40.00000			
2	I(Q1[IB])	1.00000 m			
3	I(Q1[IC])	152.37491 m			

$$\beta = \frac{IC}{IB} = \frac{152,3mA}{1mA} = 152,3$$

Datasheet

		
DC Current Gain		
at V _{CE} = 1 V, I _C = 0.1 mA	hFE	40
at Vce = 1 V, Ic = 1 mA	hFE	70
at V _{CE} = 1 V, I _C = 10 mA	hFE	100
at $V_{CE} = 1 \text{ V}$, $I_{C} = 50 \text{ mA}$	hFE	60
at V _{CE} = 1 V, I _C = 100 mA	hFE	30

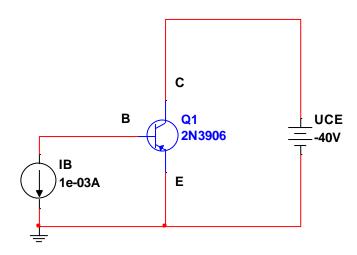
TRANSISTOR 2N3906



DC Operating Point Analysis

1 V(c) -1.00000 2 I(Q1[IB]) 999.99909 n 3 I(Q1[IC]) 183.55255 u		Variable	Operating point value		
111111111111111111111111111111111111111	1	V(c)	-1.00000		
3 I(Q1[IC]) 183.55255 u	2	I(Q1[IB])	999.99909 n		
	3	I(Q1[IC])	183,55255 u		

$$\beta = \frac{IC}{IB} = \frac{183,6\mu A}{1\mu A} = 183,6$$



DC Operating Point Analysis

	Variable	Operating point value			
1	V(c)	-40.00000			
2	I(Q1[IB])	1.00000 m			
3	I(Q1[IC])	265.22254 m			

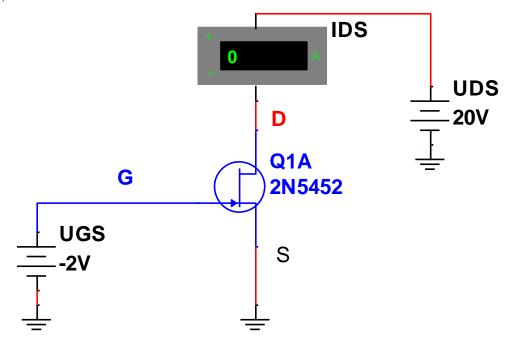
$$\beta = \frac{IC}{IB} = \frac{265,2mA}{1mA} = 265,2$$

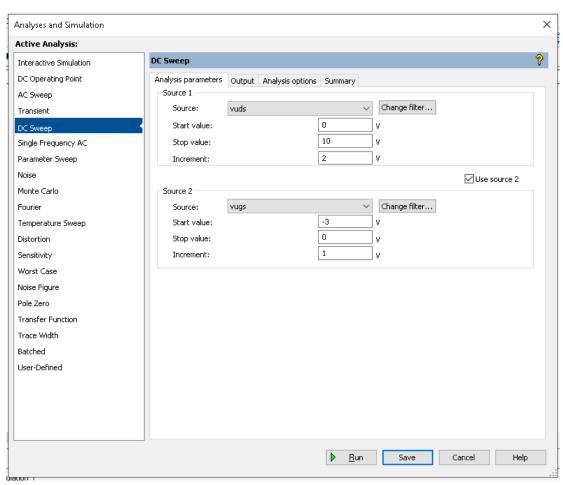
Datasheet

	hre	60	_	_	_	VcE=-1V , lc=-0.1mA
		80	_	_		VcE=-1V , lc=-1mA
C current transfer ratio		100	_	300		VcE=-1V , lc=-10mA
		60	_	_		VcE=-1V , lc=-50mA
		30	_	_		VcE=-1V , lc=-100mA

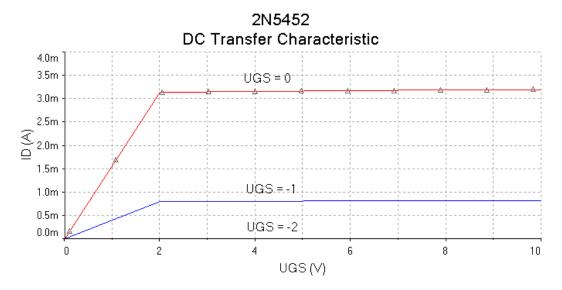
CHƯƠNG 3 FET

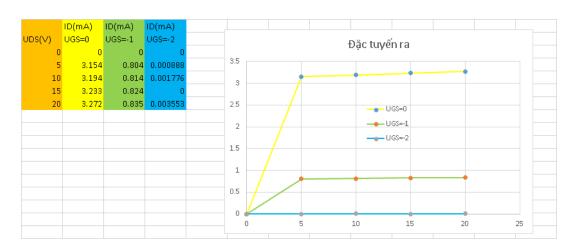
1 Đặc tuyến ra JFET





Sau đó chọn Run (ấn F5): View -> Grapher



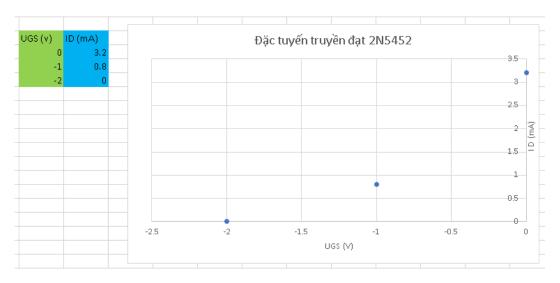


Từ kết quả đo của đặc tuyến ra có thể vẽ đặc tuyến truyền đạt. Chú ý rằng ở đây ta chọn vẽ ba điểm thay vì bốn điểm

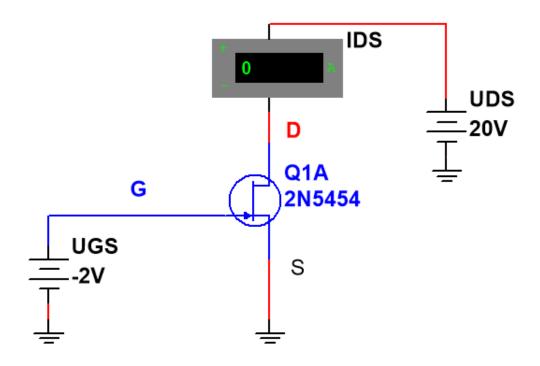
Điểm 1: UGS =0V

Điểm 2 : UGS = Up =-2V

Điểm 3 : UGS =Up/2 = -1V

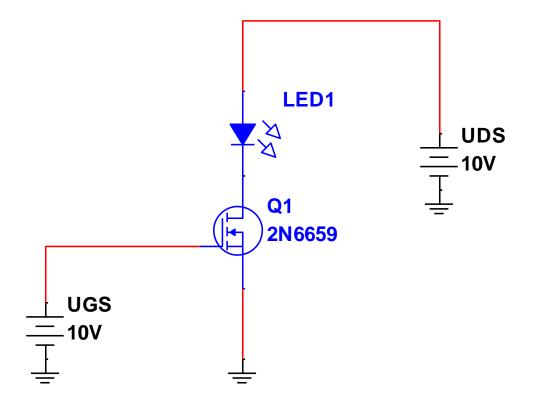


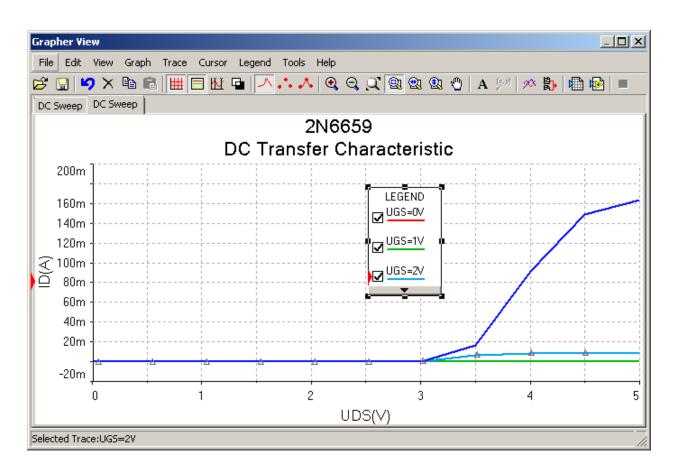
Có thể làm tương tự với 2N5454

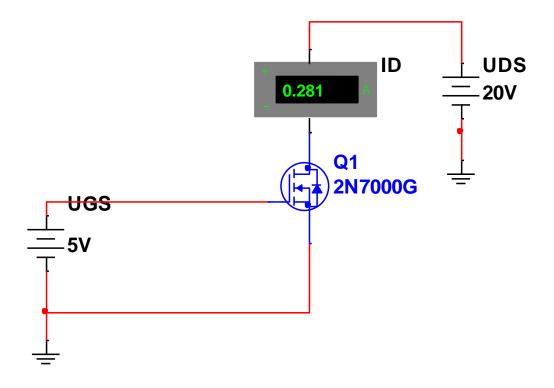


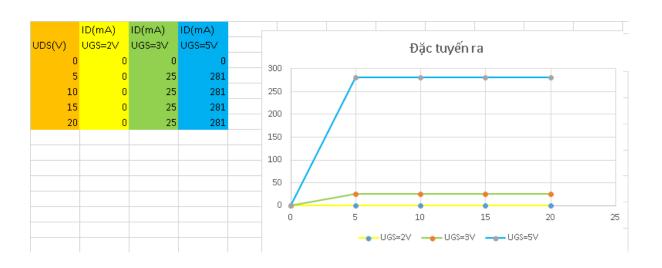
2 Đặc tuyến ra D MOSFET

3 Đặc tuyến ra của E MOSFET





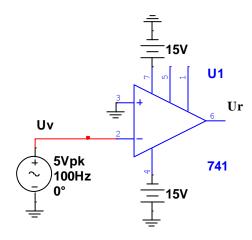




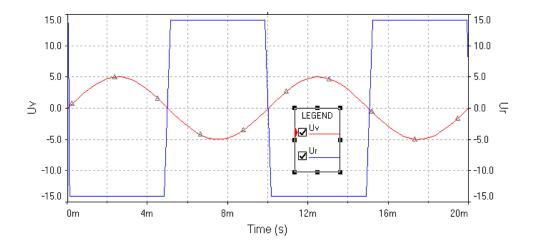
CHƯƠNG 4 IC KĐTT

- 4.1 Mạch khuếch đại đảo : tham khảo slilde bài giảng
- 4.2 Mạch khuếch đại không đảo: tham khảo slilde bài giảng
- 4.3 Mạch so sánh

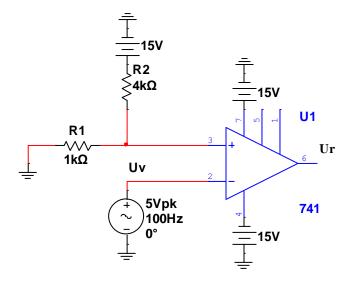
Mạch so sánh đảo Un bằng không



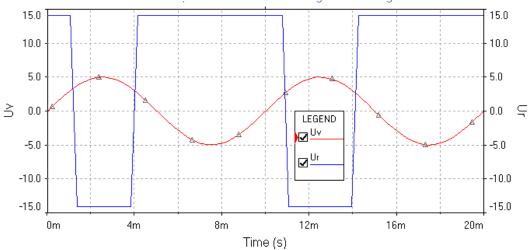
Hình Mạch so sánh đảo



Ung khác không

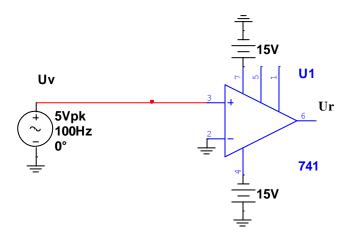


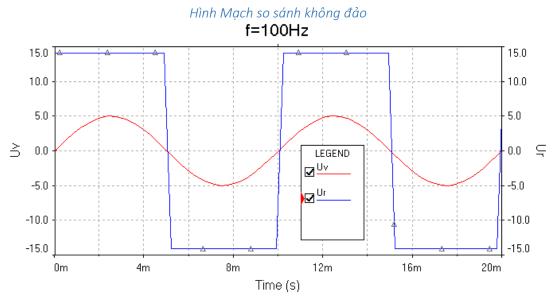
Hình Mạch so sánh đảo với Ung khác không



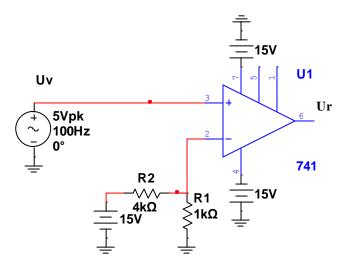
Hình Đồ thị Uv và Ur

Mạch so sánh không đảo

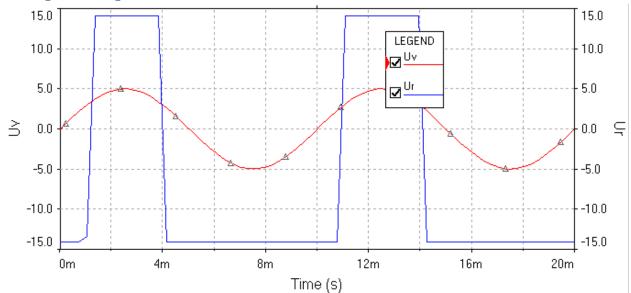




Hình Đồ thị Uv và Ur





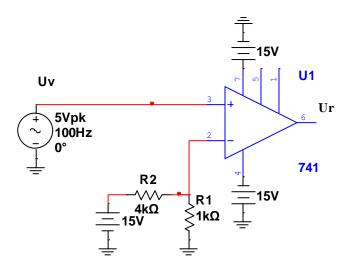


Hình Đồ thị Uv và Ur

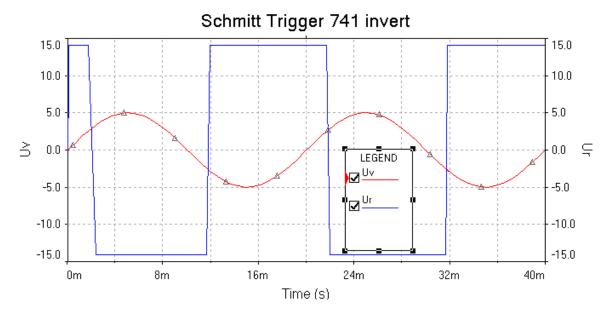
Mạch Schmitt Trigger

Mạch Schmitt Trigger đảo

Mạch Schmitt Trigger không đảo



Hình Schmitt Trigger



Hình Đồ thị tín hiệu vào Uv và Ur

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bài giảng Cấu kiện điện tử-Ths Hoàng Quang Huy

Electronic Devices and Circuit Theory 9th Ed - Robert Boylestad, Louis Nashelsky

Electronic Devices-9th ed- Thomas Floyd

Digital Fundamentals 9th Ed – Thomas L. Floyd

NI Multisim Manual

https://instrumentationlab.berkeley.edu/Lab4